

原寸大

小型SOJ高周波水晶発振器

SG-636シリーズ

- C-MOS IC使用による低消費電力
- 小型SMDパッケージにより、高密度実装が可能
- 耐熱型シリンドラAT水晶振動子内蔵で一般SMD ICと同等のハンダ付け方法が可能
- アウトプットイネーブル機能、スタンバイ機能付き

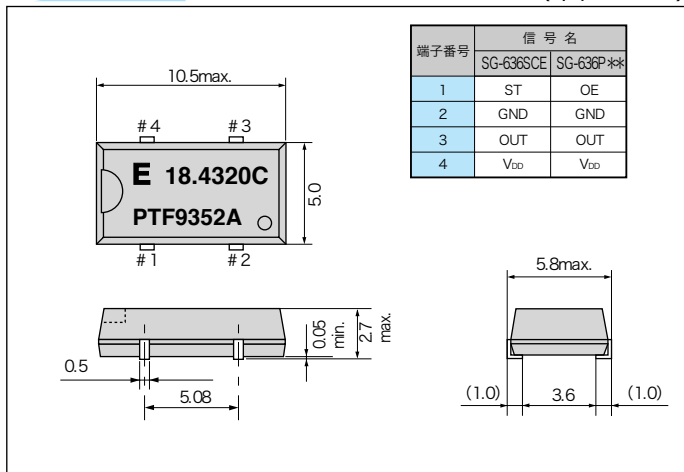
■仕様 (特性)

項目	記号	仕様				条件	
		SG-636PTF	SG-636PTJ	SG-636PH	SG-636SCE/PCE		
出力周波数範囲	$f_0$	2.21675MHz ~ 41.0000MHz	41.0001MHz ~ 70.0000MHz	2.21675MHz ~ 41.0000MHz	2.21675MHz ~ 41.0000MHz		
電源電圧	最大供給電圧	$V_{DD-GND}$	-0.5V ~ +7.0V	-0.3V ~ +7.0V	-0.5V ~ +7.0V		
	動作電圧	$V_{DD}$		5.0V ± 0.5V	3.3V ± 0.3V		
温度範囲	保存温度	$T_{STG}$	-55°C ~ +100°C				
	動作温度	$T_{OPR}$	-20°C ~ +70°C				
ハンダ付け条件	$T_{SOL}$	260°C以下 × 10秒以内 × 2回					
周波数安定度	$\Delta f/f_0$	C: ±100ppm					
消費電流	$I_{OP}$	17mA max.	35mA max.		9mA max.	無負荷	
ディセーブル時電流	$I_{OE}$	10mA max.	28mA max.	20mA max.	5mA max.	OE = GND ST = GND, 2μA max. (SCE)	
デューティ	$t_w/t$	40% ~ 60%		—	40% ~ 60%	45% ~ 55%	C-MOS負荷: 1/2 $V_{DD}$ レベル TTL負荷: 1.4Vレベル
		45% ~ 55%		—			
“H”レベル出力電圧	$V_{OH}$	$V_{DD} - 0.4V$ min.	2.4V min.	$V_{DD} - 0.4V$ min.		$I_{OH} = -8mA$ (PTF) / $-400\mu A$ (PTJ) / $-4mA$ (PH/SCE/PCE)	
“L”レベル出力電圧	$V_{OL}$	0.4V max.				$I_{OL} = 16mA$ (PTF) / $8mA$ (PTJ) / $4mA$ (PH/SCE/PCE)	
出力負荷条件 (TTL)	N	10TTL max.	5TTL max.	5LSTTL max.	—	$C_L \leq 15PF$	
出力負荷条件 (C-MOS)	$C_L$	50pF max.	15pF max.	20pF max. ( $\leq 55MHz$ ) 15pF max. ( $> 55MHz$ )	30pF max.		
“H”レベル入力電圧	$V_{IH}$	2.0V min.	3.5V min.	2.0V min.	0.8 $V_{DD}$ min.	OE端子, ST端子 (SCE)	
“L”レベル入力電圧	$V_{IL}$	0.8V max.	1.5V max.	0.8V max.	0.2 $V_{DD}$ max.		
出力上昇時間	$t_{rLH}$	7 ns max.	—	5 ns max.		C-MOS負荷: 20% → 80% $V_{DD}$ レベル	
		5 ns max.		—		TTL負荷: 0.4V → 2.4V レベル	
出力下降時間	$t_{rHL}$	7 ns max.	—	5 ns max.		C-MOS負荷: 80% → 20% $V_{DD}$ レベル	
		5 ns max.		—		TTL負荷: 2.4V → 0.4V レベル	
発振開始時間	$t_{OSC}$	4ms max.	10ms max.		4ms max.	最低動作電圧時 $t$ を 0 とする	
経時変化	$f_a$	± 5 ppm / 年 max.				$T_a = 25^\circ C$ , 初年度	
耐衝撃性	S.R.	± 20ppm max.				硬木上 75cm × 3 回 または 3000G × 0.3ms. × 1/2 Sine Wave × 3 方向	

モールド部より内蔵の金属ケースの一部が見える場合があります。

■外形寸法図

(単位: mm)



■推奨ハンダ付けパターン図

(単位: mm)

